ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ Сd_{1-x}Mn_xTe С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ

Петр ГАШИН, Снежана МЕТЕЛИЦА, Валентина НИКОРИЧ, Владимир ЦУРКАН

*Институт прикладной физики АН Молдовы

В последние годы особое внимание уделяется исследованию так называемых разбавленных магнитных полупроводников, к которым относятся тройные соединения $Cd_{1-x}Mn_xTe$ [1]. Замена катионов металла (Cd) на магнитные ионы (Mn^{2+}) значительно изменяет магнитные свойства данных соединений, что связано с возрастающим влиянием взаимодействия между свободными носителями заряда и магнитными локальными моментами ионов Mn. Обнаружено, что добавление ионов марганца в CdTe приводит к появлению в нем антиферромагнитных свойств [1], а при низких концентрациях Mn (x<0,3) в области низких температур — фазы спинового стекла [2].

Исследованные кристаллы $Cd_{1-x}Mn_x$ Те были выращены методом Бриджмена из расплавов, в которые вводилось определенное количество Mn ($x=0,13;\ 0,3;\ 0,5$). Однако, как правило, при использовании такого метода выращивания происходит перераспределение компонентов вдоль слитка, что связано с различием коэффициентов сегрегации компонентов в данном соединении. Для исследований выбирались кристаллы, вырезанные из начальных участков слитков.

В интервале температур 1,79<T \leq 400 К при напряженности магнитного поля H = 10^4 Э была исследована температурная зависимость магнитной восприимчивости.

Учитывая, что температурная зависимость магнитной восприимчивости χ должна подчиняться известному закону Кюри-Вейсса [3], который можно записать в виде

$$\frac{1}{\chi} = -\frac{\theta}{C} + \frac{T}{C} \tag{1}$$

полученные температурные зависимости были построены в координатах $1/\chi = f(T)$.

Как видно из рис.1, в области температур $T>45~\mathrm{K}$ для всех образцов зависимость $1/\chi=f(T)$ является линейной, что указывает на то, что температурная зависимость магнитной восприимчивости подчиняется закону Кюри-Вейсса.

При температурах ниже 45 К на полученных зависимостях для кристаллов 1 и 2 наблюдается изменение наклона, что характерно для перехода в состояние спинового стекла. Однако у образца 3 при низких

температурах появляется излом, свойственный антиферромагнетикам.

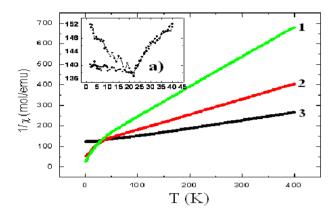


Рис. 1. Температурная зависимость магнитной восприимчивости кристаллов $Cd_{1-x}Mn_xTe$: 1-x=0,13; 2-x=0,3; 3-x=0,5. а) зависимость $1/\chi$ (T) для образца 3 при T<45K и H = 20 Э.

Постоянная Кюри-Вейсса C рассчитывалась из наклона полученных зависимостей, аппроксимация линейного участка к оси температур, позволила определить точку Кюри θ . Согласно (1), экспериментальные кривые можно записать в виде:

образец 1: $1/\chi = 103,704 + 1,4409T$;

образец 2:1/ χ = 103,97 + 0,750T; образец 3: 1/ χ = 116, 03 + 0,365T.

Кроме того, используя известную формулу связи макроскопических и микроскопических параметров

$$\mu_{eff} \approx \sqrt{8 \cdot \chi_m \cdot T} \,,$$
 (2)

где χ_m — молярная восприимчивость, можно определить концентрацию атомов Mn в твердом растворе (Таблица 1).

Tаблица 1 Основные магнитные параметры кристаллов $\mathrm{Cd}_{\mathrm{Lx}}\mathrm{Mn}_{\mathrm{x}}\mathrm{Te}$

Величина	Состав расплава, х		
	0,13	0,3	0,5
θ, Κ	72	139	318
С, К	0,694	1,33	2,74

X, _{экспер} 0,15	0,3	0,62
---------------------------	-----	------

Исследование магнитных свойств $Cd_{1-x}Mn_x$ Те позволило определить концентрацию Mn в испытуемых образцах. Самой близкой по значению к заявленной концентрации оказалась концентрация марганца в образце с x=0,3. Несовпадение экспериментальной концентрации с концентрацией в расплаве подтверждает неоднородное распределение компонента Mn в твердых растворах $Cd_{1-x}Mn_x$ Te.

Библиография:

- 1. W. J. M. de JONGE, H. J. M. SWAGTEN. Magnetic properties of diluted magnetic semiconductors. In *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*, 1991, 100, pp. 322 345.
- 2. M. ESCORNE, A. MAUGER, R. TRIBOULET and J.L. THOLENCE. Magnetic properties of Cd_{1-x}Mn_xTe at low temperatures. In: *Physica*. 1981,107B, pp. 309 310.
- 3. С. КРУПИЧКА. Физика ферритов и родственных им магнитных окислов. Москва, 1976.